

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成30年2月8日(2018.2.8)

【公開番号】特開2015-144258(P2015-144258A)  
 【公開日】平成27年8月6日(2015.8.6)  
 【年通号数】公開・登録公報2015-050  
 【出願番号】特願2014-256896(P2014-256896)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/8234 (2006.01)  
 H 0 1 L 27/088 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/336 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/28 (2006.01)  
 H 0 1 L 29/417 (2006.01)  
 H 0 1 L 29/423 (2006.01)  
 H 0 1 L 29/49 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/8242 (2006.01)  
 H 0 1 L 27/108 (2006.01)  
 H 0 1 L 27/115 (2017.01)  
 H 0 1 L 29/788 (2006.01)  
 H 0 1 L 29/792 (2006.01)  
 H 0 1 L 27/105 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/316 (2006.01)  
 H 0 1 L 51/50 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/473 (2006.01)

## 【 F I 】

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B  
 H 0 1 L 27/08 1 0 2 E  
 H 0 1 L 27/08 1 0 2 H  
 H 0 1 L 29/78 6 1 7 T  
 H 0 1 L 29/78 6 1 7 U  
 H 0 1 L 29/78 6 1 9 A  
 H 0 1 L 21/28 3 0 1 B  
 H 0 1 L 29/50 M  
 H 0 1 L 29/58 G  
 H 0 1 L 27/10 3 2 1  
 H 0 1 L 27/10 4 3 4  
 H 0 1 L 29/78 3 7 1  
 H 0 1 L 29/50 J  
 H 0 1 L 27/10 4 4 1  
 H 0 1 L 21/316 Y  
 H 0 5 B 33/14 A  
 H 0 1 L 21/473

【手続補正書】  
 【提出日】平成29年12月18日(2017.12.18)  
 【手続補正1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の絶縁層と、

前記第 1 の絶縁層上の酸化物半導体層と、

前記酸化物半導体層に接する一对の電極層と、

前記酸化物半導体層及び前記一对の電極層に接する第 2 の絶縁層と、

前記酸化物半導体層と前記第 2 の絶縁層を介して対向するゲート電極層と、

前記ゲート電極層上の第 3 の絶縁層と、を有し、

前記第 1 の絶縁層及び前記第 3 の絶縁層の少なくとも一方は、ボロンを含む酸化アルミニウムを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記第 1 の絶縁層又は前記第 3 の絶縁層に対する SIMS 分析によるボロンの最大濃度が  $5.0 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$  以上、 $1.0 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$  以下であることを特徴とする半導体装置。